

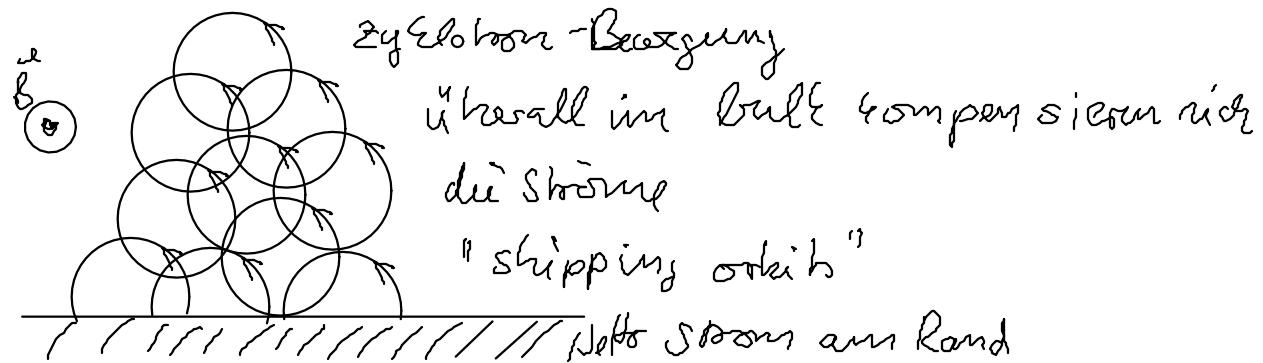
Inhalt der Vorlesung Nanoelektronik

I Konzept
II Landauer
III Hall-Effekt

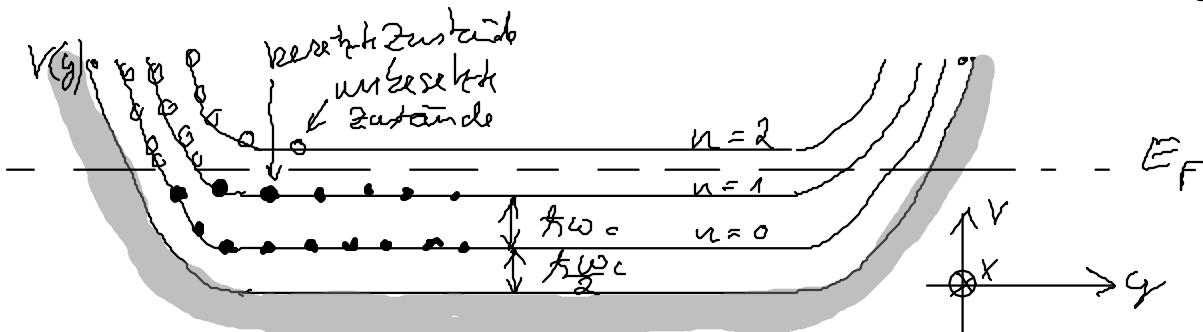
IV QHE
V Interferenz-Effekt $\xleftarrow{\text{Aharonov-Bohm}}$
Schwache Lokalisierung
VI Spintronics $\xleftarrow{\text{GMR}}$ Universal cond. funct
VII Einzel-Elektronen Effekte $\xleftarrow{\text{Stern-Brown}}$

4.4 Randkanäle

- Übersicht



- QM Landau-Niveaus sind am Rand nach oben gebogen



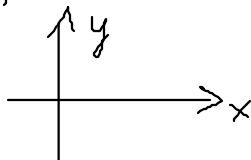
$$\text{Umgekehrt gilt } E_{n,k} \approx \frac{\hbar}{2} \omega \left(n + \frac{1}{2} \right) + V(y_n) \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

$$\Psi_{n,k}(x, y) = K_n(y - y_n) e^{i k x} \quad y_n = \frac{\hbar c}{e B} \quad \text{R}$$

$$\text{Gruppengeschwindigkeit } v_x = \frac{1}{\hbar} \frac{\partial E_{n,k}}{\partial k} = \frac{1}{\hbar} \frac{\partial V}{\partial y} \frac{\hbar c}{e B} \neq 0$$

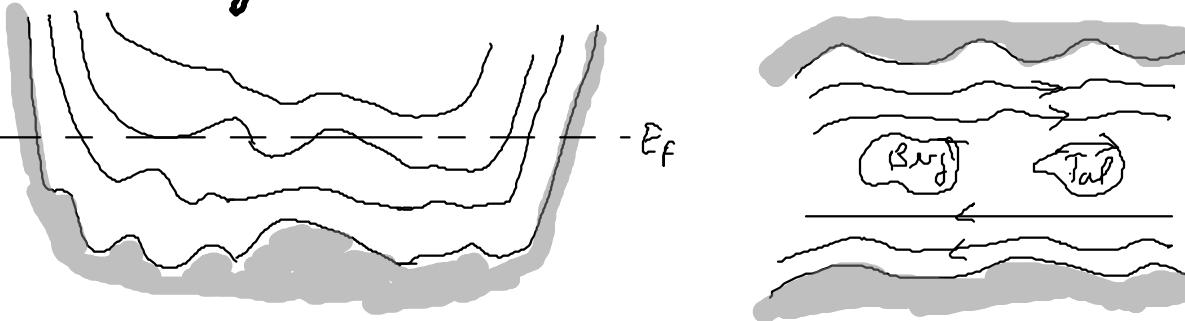
- am Rand verschiedenes Vorzeichen

- beobachtete Randkanäle, was passiert bei E_F



- Strom $j_x = e N(E_F) v_x \text{ eV} = \frac{e^2}{\pi} V$
- Zustandsdichte $N(E) = \frac{1}{2\pi} \left(\frac{\partial E}{\partial k} \right)^{-1} = \frac{1}{2\pi\hbar} \frac{1}{v_x}$
- Gruppengeschw. • Zustandsdichte = const
 $\Rightarrow G = 2 \frac{e^2}{\hbar}$ pro Kanal
 Spin $\sqrt{\hbar}$

• Mardonierung



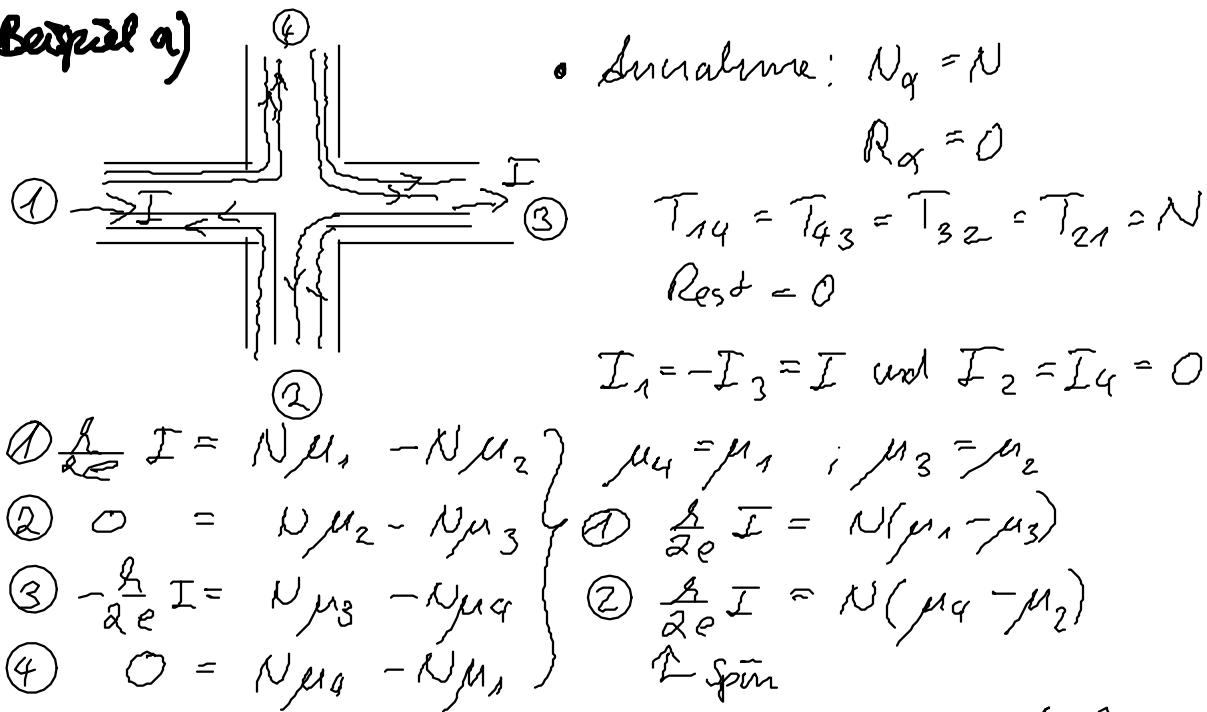
- Schmale Potential nicht zu stark angeordnet ist, und die Randkanäle auf beiden Seiten entkoppelt

Hall Probe

Büttiker: Mult'-Proben, Multi-Kanal-Formel

$$\frac{h}{2e} I_\alpha = (N_\alpha - R_\alpha) \mu_\alpha - \sum_{\beta \neq \alpha} T_{\beta \rightarrow \alpha} \mu_\beta$$

Beispiel a)



• Hall-Widerstand $R_{14} = R_{1342} = \frac{\mu_4 - \mu_2}{e I} = \frac{1}{N} \frac{g}{2e^2}$

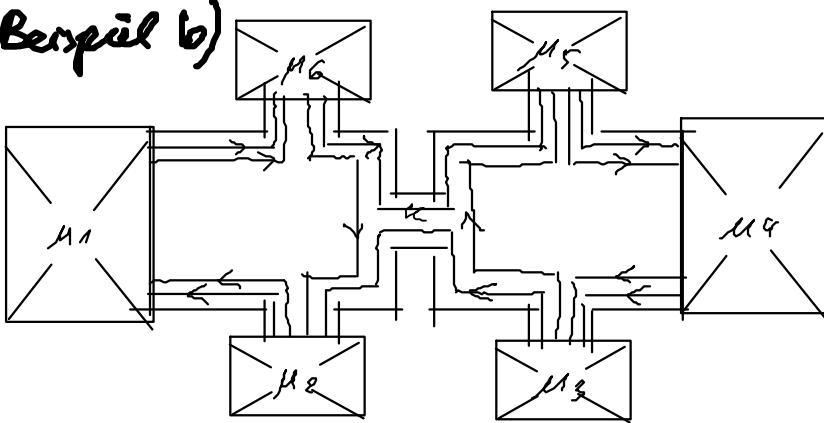
Stromkontakte Spannungskontakte

$$\Rightarrow \text{garantiert Hall-Widerstand } R_H^{-1} = N \frac{2e^2}{h}$$

• Transports widerstand

$$R_{13,13} = \frac{\mu_1 - \mu_3}{e I} = \frac{1}{N} \frac{h}{2e^2} \quad \text{auch garantiert, wegen Quadertransport}$$

Beispiel b)



• Hall-Widerstand

$$R_H = R_{1462} = ?$$

• 2-Punkt-Transportwiderstand

$$R^{(2P)} = R_{14,14} = ?$$

• 4-Punkt-Transportwiderstand

$$R^{(4P)} = R_{1456} = ?$$

• Einschränkung \rightarrow partielle Rückstruktur

Rechenweg als Übung

$$T_{16} = N = T_{54} = T_{43} = T_{21} \Rightarrow R_H = \frac{1}{N} \frac{h}{2e^2}$$

$$T_{62} = k ; T_{62} = N - k \quad R^{(2P)} = \frac{1}{k} \frac{h}{2e^2}$$

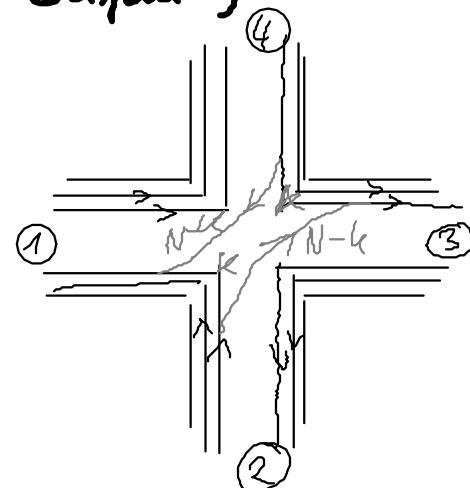
$$T_{32} = k ; T_{35} = N - k \quad R^{(4P)} = \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{N} \right) \frac{h}{2e^2}$$

- Es gilt wieder $R^{(2P)} = R^{(4P)} + \underbrace{\frac{1}{N} \frac{h}{2e^2}}_{\text{Kontaktwiderstand}}$

- ohne Einschränkung $k = N \Rightarrow R^{(4P)} = 0$

$$k = 0 \Rightarrow R^{(4P)} = \infty$$

Beispiel c)



$$T_{14} = N = T_{32} \Rightarrow R_H = \frac{h}{2e^2} \frac{1}{k}$$

$$T_{43} = k = T_{21}$$

$$T_{41} = N - k = T_{23} \quad \bullet \text{ nicht mehr garantiert}$$

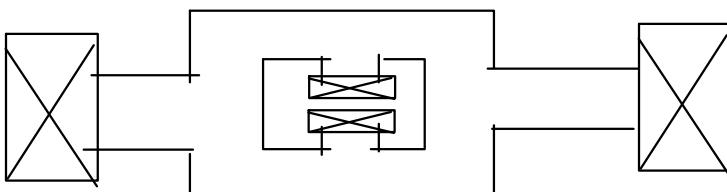
$$\text{Rest} = 0$$

• nicht mehr garantiert

• k ist keine ganze Zahl

Beispiel d)

$$R_{1234} = ?$$



Rand Elektrofeld liefert richtige Ergebnisse für Gesamtstrom aber falsche Ergebnisse für Stromverteilung

4.5 Kompressible und unkompressible Bereiche

